

要 約 書

レジストパターンが形成されたウエハWに薬液であるDHFを供給してウエハW表面の酸化膜をエッチングにより除去し、ウエハWにリンス液を供給してウエハW表面を洗浄し、その後、ウエハWに所定濃度のオゾン水を供給してウエハWの表面を親水性にすべく酸化膜を形成する。そして、ウエハWにN₂ガス（乾燥気体）を供給してウエハW表面に付着する水分を除去する。これにより、ウエハWに形成されたレジストパターンを崩さず、かつウォーターマークの発生を抑制して品質及び歩留まりの向上を図ることができる。

特許庁
特許第1400000号
発明の名称
半導体装置の製造方法
発明者
株式会社半導体技術研究所
代理人
特許事務所